



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

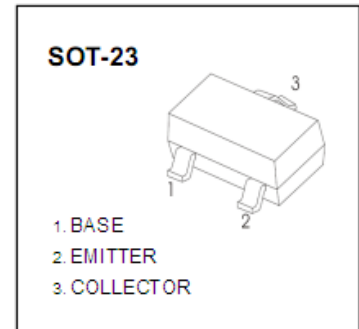
SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

## MMBT4403 ( PNP )

印章/Marking : 2T

用途/Applications :

用于一般开关电路。



### 极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	$V_{CB0}$	-40	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	$V_{CE0}$	-40	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	$V_{EB0}$	-5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	$I_C$	-0.6	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	$P_C$	0.3	W
结温/Junction Temperature	$T_j$	150	°C
储存温度/Storage Temperature	$T_{stg}$	-55~150	°C

### 电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_C = -100 \mu A, I_E = 0$	-40		V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_C = -1mA, I_B = 0$	-40		V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E = -100 \mu A, I_C = 0$	-5		V
集电极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = -35V, I_E = 0$		-0.1	$\mu A$
发射极截止电流	$I_{EB0}$	$V_{EB} = -4V, I_C = 0$		-0.1	$\mu A$
集电极发射极穿透电流	$I_{CEO}$	$V_{CE} = -35V, I_B = 0$		-0.1	$\mu A$
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -150mA, I_B = -15mA$		-0.4	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -150mA, I_B = -15mA$		-0.95	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE} = -10V, I_C = -20mA, f = 100MHz$	200		MHz
延迟时间	$t_d$	$V_{CC} = -30V, V_{BE} = -2V,$		10	nS
上升时间	$t_r$	$I_C = -150mA, I_{B1} = -15mA$		25	nS
存储时间	$t_s$	$V_{CC} = -30V, I_C = -150mA,$		225	nS
下降时间	$t_f$	$I_{B1} = -I_{B2} = -15mA$		30	nS